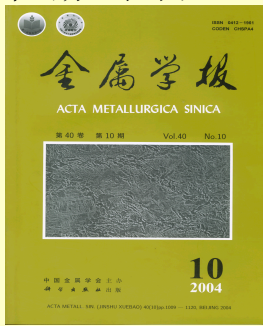


## 本期封面



2004年10期

栏目:

DOI:

论文题目: 脉冲偏压电弧离子镀沉积温度的计算

作者姓名: 白晓 林国强 董闯 闻立时

工作单位: 大连理工大学三束材料改性国家重点实验室, 大连 116024

通信作者: 林国强

通信作者Email: [gqlin@dlut.edu.cn](mailto:gqlin@dlut.edu.cn)

文章摘要: 针对脉冲偏压电弧离子镀技术, 分析了影响基体沉积温度的各项因素及其影响程度。在直流偏压电弧离子镀沉积温度计算模型的基础上, 在偏压输出波形为近方波的相对规范形状的条件下, 将脉冲离子轰击输入能量功率等效成直流输入功率与占空比的乘积, 再基于能量平衡原理建立脉冲偏压电弧离子镀基体沉积温度的理论计算模型, 最后用实测的沉积温度对计算模型进行检验, 在-1000—0 V的偏压范围内, 理论与实验得到了好的吻合。

关键词: 电弧离子镀, 脉冲偏压, 沉积温度

分类号: TB43

关闭